

Titulació	Tipus	Curs
Física	OP	4

Professor/a de contacte

Nom : Galien Grosjean

Correu electrònic : galien.grosjean@uab.cat

Equip docent

Cristian Rodriguez Tinoco

Idiomes dels grups

Podeu consultar aquesta informació al [final](#) del document.

Prerequisits

És recomanable, tot i que no és imprescindible, haver cursat *Estat Sòlid*.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és donar els fonaments per que l'estudiant pugui entendre la variació de les propietats físiques (electròniques, òptiques, tèrmiques, magnètiques i de transport) dels materials a l'escala nanomètrica.

Resultats d'aprenentatge

1. Fer treballs acadèmics de manera independent usant bibliografia (especialment en anglès), bases de dades i col·laborant amb altres professionals.
2. Comunicar eficaçment informació complexa de manera clara i concisa, ja sigui oralment, per escrit o mitjançant TIC, i en presència de públic, tant a públics especialitzats com generals.
3. Raonar críticament, tenir capacitat analítica, usar correctament el llenguatge tècnic i elaborar arguments lògics.
4. Treballar autònomament, tenir iniciativa pròpia, ser capaç d'organitzar-se per assolir uns resultats i planejar i executar un projecte.
5. Treballar en grup, assumir responsabilitats compartides i interaccionar professionalment i de manera constructiva amb altres persones amb un respecte absolut als seus drets.
6. Relacionar la dimensionalitat amb les dimensions característiques de les partícules en la nanoescala.
7. Identificar la importància de la dimensionalitat en les propietats electròniques, tèrmiques, òptiques, magnètiques i de transport en els materials.
8. Correlacionar les modificacions de les propietats físiques en la nanoescala amb el desenvolupament de nous dispositius.

9. Calcular l'absorció i emissió de llum en nanopartícules semiconductores.
10. Utilitzar el formalisme de Landauer per descriure el transport balístic.
11. Identificar els principis bàsics del transport electrònic i fonònic per a la seva posterior aplicació en sistemes avançats de baixa dimensionalitat.
12. Aprofundir en la descripció de la interacció radiació-matèria en sistemes manomètrics.
13. Obtenir models simplificats de bandes d'energia per descriure el comportament electrònic de sòlids de baixa dimensionalitat.
14. Identificar les modificacions de les propietats físiques en disminuir la mida a l'escala nanomètrica.
15. Interpretar la simplificació de les equacions de transport en el límit balístic.
16. Utilitzar el càlcul en una i diverses variables, les equacions diferencials i el càlcul matricial en l'estudi de les propietats físiques dels nanomaterials.
17. Calcular i analitzar les característiques del gas d'electrons bidimensional.
18. Simular les propietats de transport mitjançant analogies amb circuits electrònics.
19. Calcular diagrames de bandes en sistemes de dimensionalitat baixa.
20. Racionalitzar els resultats obtinguts al laboratori en relació amb els fenòmens físics observats considerant la influència de la dimensionalitat en les mesures experimentals.
21. Mesurar la luminescència de punts quàntics semiconductors.
22. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
23. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
24. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.

Continguts

1. Mètodes d'obtenció de NANOCRISTALLS i MATERIALS nanocrystal·lins

1.1. Nucleació i Creixement

1.2 A partir de fase vapor

1.3. A partir de fase líquida

1.4. A partir de fase sòlida

2. Efectes de GRANDÀRIA en les propietats físiques.

2.1 Propietats electròniques: Confinament en 1,2,3 dimensions

2.1.1. Xarxa lineal o circular d'àtoms de carboni.

2.1.2. Partícules en pous de potencial quadrats.

2.1.3. Estructura de bandes i densitat d'estats en funció de la dimensionalitat.

2.1.4. Confinament en presència d'un camp elèctric: pou de potencial triangular.

2.1.5. Confinament en presència d'un camp magnètic: pou de potencial parabòlic.

2.1.5.1. Nivells de Landau. Efecte Hall quàntic.

2.2. Propietats de transport electrònic

2.2.1 Transport bal·lístic: Formulisme de Landauer

2.2.2. Transport túnel: Funció esglaó. Barrera quadrada. Corrent en 1D. Efecte túnel ressonant. Tunnelling en heteroestructures.

2.2.3 Aplicacions: Dispositius electrònics i magnètics basats en heteroestructures.

2.3. Propietats òptiques

2.3.1 Excitons: interaccions coulombianes.

2.3.2 Emissió i absorció de llum (interbanda, intrabanda).

2.3.3 Aplicacions tecnològiques

2.3.4 Lectura

2.4. Propietats tèrmiques i termoelectricitat

2.4.1 Capacitat calorífica

2.4.2 Temperatura i entalpia de fusió en nanoparticules metàl·liques i semi conductores.

2.4.3 Transport tèrmic.

2.4.4 Efectes Seebeck i Peltier

Pràctiques de laboratori.

2. Influència de la grandària sobre l'emissió de llum en punts quàntics semiconductors de CdSe.
4. Determinació de la corba IV del díode túnel ressonant
6. Transport tèrmic en sistemes bidimensionals

Activitats formatives i Metodologia

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Classes de teoria	27	1,08	
Laboratori	7	0,28	
Classes de problemes	12	0,48	
Resolució de problemes i lliurament de problemes addicionals	17	0,68	
Classes de discussió d'articles científics	3	0,12	
Tutories	5	0,2	
Estudi i preparació d'examens	51	2,04	
Realització de treballs	20	0,8	

En aquest curs s'ofereix un ensenyament específic on hi hauran les diferents activitats formatives que es descriuen a continuació. Les hores de treball que s'especifiquen per a cada activitat formativa corresponen a un alumne promig. Naturalment, no tots els alumnes necessiten el mateix temps per a aprendre conceptes i dur a terme determinades activitats, de manera que la distribució de temps s'ha d'entendre com a orientativa. En aquesta assignatura s'intenta potenciar la participació activa de l'estudiant com una eina rellevant d'aprenentatge.

Activitats formatives dirigides:

Classes magistrals: classes en les que el professor de teoria explica els conceptes més rellevants de cada tema. Habitualment són classes de pissarra, malgrat que en algunes ocasions és fan classes amb programes d'ordinador. Els alumnes disposen d'apunts al campus virtual o de còpia de les transparències en format pdf amb antelació i dins el campus virtual de la UAB.

Classes de problemes: classes en les que el professor de problemes explica als alumnes com es resolen els problemes tipus de l'assignatura. El professor resoldrà en detall una llista de problemes seleccionats, i

proposarà als alumnes una llista de problemes que s'han de lliurar de forma obligatòria, doncs formen part de l'avaluació de l'assignatura.

Classes de discussió: Es recomana la lectura d'articles científics en relació directa a la temàtica de l'assignatura i es discuteix els seu contingut en classe.

Pràctiques de laboratori: Els alumnes realitzaran pràctiques de laboratori com una eina més d'aprenentatge.

Activitats formatives supervisades:

Tutories: en les hores d'atenció als alumnes, els professors estaran disponibles per a les consultes dels alumnes que tinguin dubtes en qualsevol dels temes del temari.

Activitats formatives autònomes:

Resolució de problemes i lliurament de tasques addicionals: l'alumne ha de resoldre els problemes de la llista que lliuren els professors i els addicionals que li demani el professor de problemes o els que l'alumne vulgui fer pel seu compte per a preparar-se millor l'assignatura.

Estudi i preparació d'exàmens: Treball personal de l'alumne per tal d'adquirir els conceptes teòrics de l'assignatura i les habilitats per a la resolució de problemes.

Treballs: de manera opcional els estudiants poden fer treballs que demanen un nivell de programació adient per resoldre problemes en relació als temes de l'assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, perquè l'alumnat completi les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura.

Avaluació

Activitats d'avaluació continuada

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Repesca parcials	80%	3	0,12	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24
Examen parcial II	40%	2	0,08	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24
Examen parcial I	40%	2	0,08	2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24
Lliurament de problemes i lectura d'articles	10%	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24
Pràctiques de laboratori	10%	1	0,04	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23

Resolució de problemes i participació en lectures: 10 % de la nota final.

Treballs pràctiques (realització, informe, entrevista): 10 % de la nota final.

Examen1 : 40% de la nota final.

Examen 2: 40% de la nota final

Examen repesca: 80% nota final (per tal de poder-se presentar a l'examen de repesca, heu d'haver estat prèviament avaluats d'almenys 2/3 de la nota final)

Avaluació única

Les persones que decideixin adherir-se a l'opció d'avaluació única hauran de fer un únic examen on s'avaluaran dels continguts de la matèria explicats durant tot el curs. Aquest examen tindrà lloc el mateix dia que la resta d'alumnes realitzen el segon parcial i comptarà un 80% de la nota final.

Les sessions de laboratori, així que l'entrega d'informes (10% de la nota final) i l'entrega dels exercicis proposats a classe (10% de la nota final) són obligatoris. En aquest cas, però, el lliurament de totes aquestes entregues es realitzarà el dia de l'examen.

En el cas en què la nota final de l'assignatura sigui inferior a 5, qui segueixi l'avaluació única tindrà l'oportunitat de fer un segon examen que de nou comptarà el 80% de la nota final. La data d'aquest segon examen serà notificada per la coordinació del grau.

Bibliografia

Solid State Physics, N.W.Ashcroft, N.D. Mermin, Saunders College Publishing.

The Physics of Low dimensional semiconductors: An introduction, J.H.Davies, Cambridge University Press, 1997.

Quantum semiconductor structures: Fundamentals and applications , C.Weisbuch, B.Vinter, Academic Press, 1991.

Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications, Ed. A. S. Edelstein, R. C. Cammarata, Institute of Physics, 1998.

The atomistic nature of crystal growth, B.Mutaftschiev,... Springer-verlag, 2003.

Programari

No es requereix cap programari específic.

Grups i idiomes de l'assignatura

La informació proporcionada és provisional fins al 30 de novembre.
A partir d'aquesta data, podreu consultar l'idioma de cada grup a través d'aquest [enllaç](#). Per accedir a la informació, caldrà introduir el CODI de l'assignatura

Tipus de docència	Grup	Idioma	Semestre	Torn
(TE) Teoria	1	Anglès	segon quadrimestre	matí-mixt
(PAUL) Pràctiques d'aula	1	Anglès	segon quadrimestre	matí-mixt
(PLAB) Pràctiques de laboratori	1	Anglès	segon quadrimestre	matí-mixt
(PLAB) Pràctiques de laboratori	2	Anglès	segon quadrimestre	matí-mixt